

2SD2124(L) / (S)

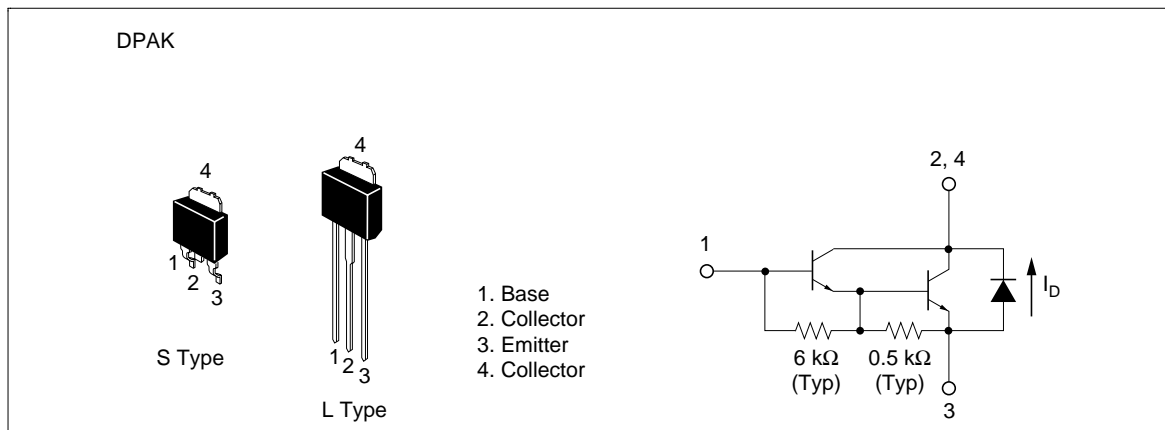
シリコン NPN エピタキシャル形

HITACHI

特長

- 低周波電力増幅用

外観図



2SD2124(L) / (S)

絶対最大定格

(Ta = 25)

項目	記号	2SD2124(L) / (S)	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	1.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	3.0	A
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	18	W
接合部温度	T_j	150	
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	
C-E 間ダイオード順方向電流	I_D^{*1}	1.5	A

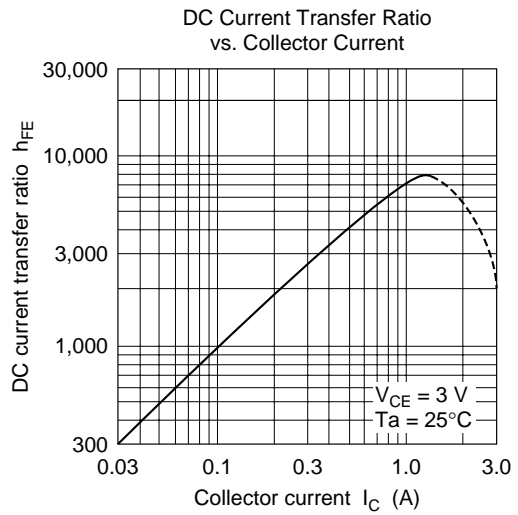
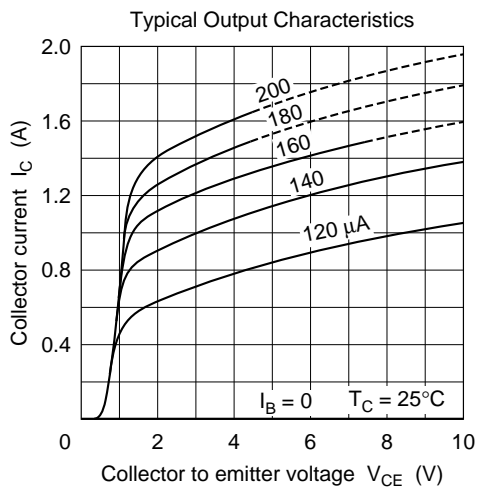
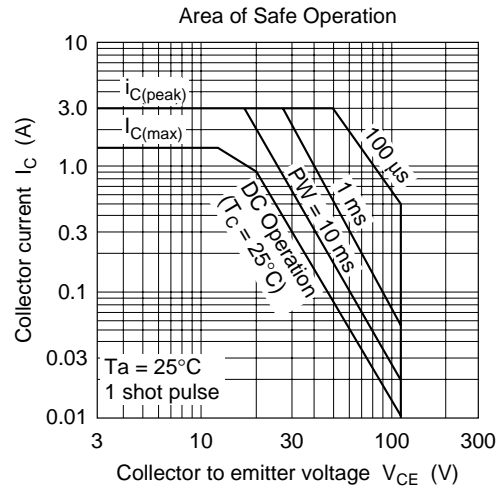
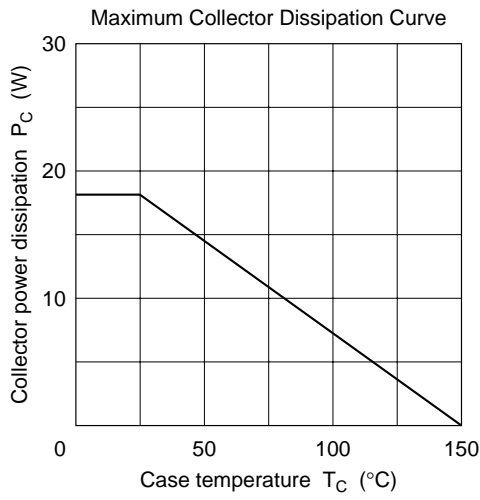
【注】 1. $T_C = 25$ における許容値

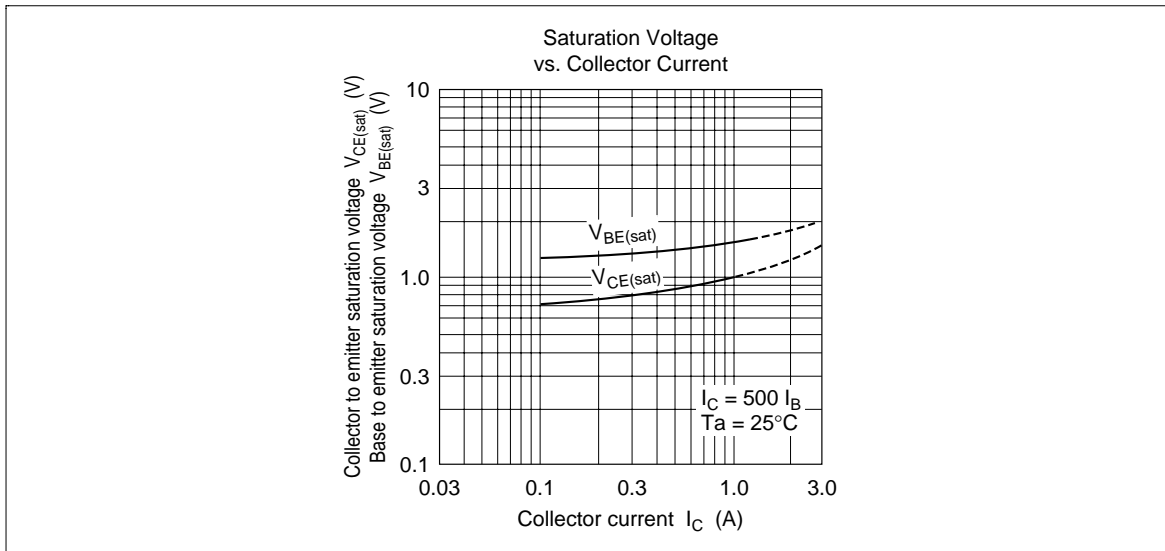
電気的特性

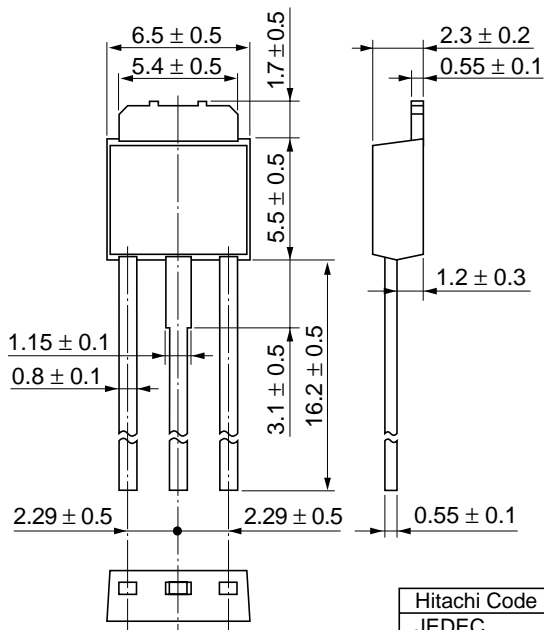
(Ta = 25)

項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	120	—	—	V	$I_C = 0.1mA, I_E = 0$
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	120	—	—	V	$I_C = 10mA, R_{BE} =$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	7	—	—	V	$I_E = 50mA, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	10	μA	$V_{CB} = 100V, I_E = 0$
	I_{CEO}	—	—	10	μA	$V_{CE} = 100V, R_{BE} =$
直流電流増幅率	h_{FE}	2000	—	30000		$V_{CE} = 3V, I_C = 1A^{*1}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C = 1A, I_B = 1mA^{*1}$
	$V_{CE(sat)}$	—	—	2.0	V	$I_C = 1.5A, I_B = 1.5mA^{*1}$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	2.0	V	$I_C = 1A, I_B = 1mA^{*1}$
	$V_{BE(sat)}$	—	—	2.5	V	$I_C = 1.5A, I_B = 1.5mA^{*1}$
C-E 間ダイオード順方向電圧	V_D	—	—	3.0	V	$I_D = 1.5A$
ターンオン時間	t_{on}	—	0.5	—	μs	$I_C = 1A, I_{B1} = -I_{B2} = 1mA$
ターンオフ時間	t_{off}	—	2.0	—	μs	

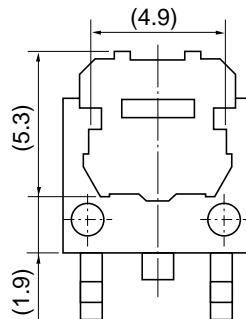
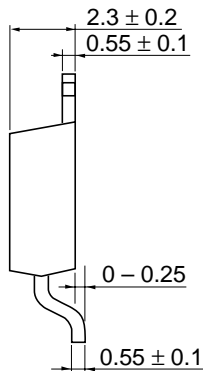
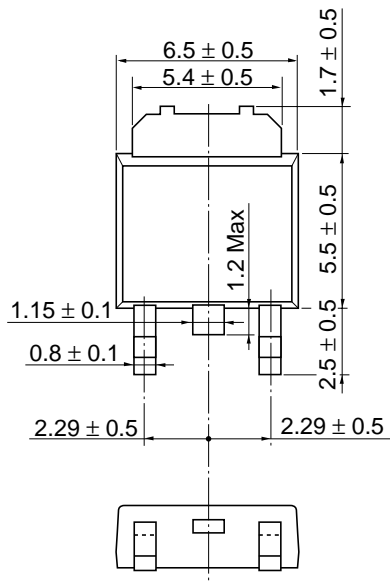
【注】 1. パルス測定







Hitachi Code	DPAK (L)-(1)
JEDEC	—
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	0.42 g



Hitachi Code	DPAK (S)
JEDEC	—
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	0.28 g